

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4063255号
(P4063255)

(45) 発行日 平成20年3月19日(2008.3.19)

(24) 登録日 平成20年1月11日(2008.1.11)

(51) Int.Cl.

F 1

H03H	9/19	(2006.01)	HO3H	9/19	J
H03B	5/32	(2006.01)	HO3B	5/32	H
H03H	9/02	(2006.01)	HO3H	9/02	D
H03H	9/215	(2006.01)	HO3H	9/02	K

HO3H 9/215

請求項の数 24 (全 23 頁)

(21) 出願番号

特願2004-182630 (P2004-182630)

(22) 出願日

平成16年6月21日 (2004.6.21)

(62) 分割の表示

特願2001-392904 (P2001-392904)

の分割

原出願日 平成13年12月25日 (2001.12.25)

(65) 公開番号

特開2004-266873 (P2004-266873A)

(43) 公開日

平成16年9月24日 (2004.9.24)

審査請求日 平成16年12月27日 (2004.12.27)

(31) 優先権主張番号

特願2000-392934 (P2000-392934)

(32) 優先日

平成12年12月25日 (2000.12.25)

(33) 優先権主張国

日本国 (JP)

(73) 特許権者 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(74) 代理人 110000626

特許業務法人 英知国際特許事務所

(72) 発明者 北村 文孝

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

(72) 発明者 坂田 淳一郎

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

(72) 発明者 棚谷 英雄

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】振動片の製造方法、振動子の製造方法、発振器の製造方法及び電子機器の製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

切り込み部を有する基部と、前記基部から突出して形成され、その表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されている振動腕部を有し、前記溝部内に溝電極が形成され、前記振動腕部の側面に側面電極が形成されている振動片の製造方法であって、前記振動片に電極膜を形成する電極膜形成工程と、前記溝電極と前記側面電極とをパターニングするためのレジストパターンを形成するレジストパターン形成工程と、前記レジストパターン形成工程で前記レジストパターンにより形成された短絡防止用間隔を調整するために、前記レジストパターンの外形に対してレーザを照射するパターン形状調整工程と、前記レジストパターンをマスクとして前記電極膜をエッチングし、前記溝電極と前記側面電極を形成する工程と、を有することを特徴とする振動片の製造方法。

【請求項 2】

前記レーザがYAGレーザの3倍高調波を用いることを特徴とする請求項1に記載の振動片の製造方法。

【請求項 3】

前記溝部が前記振動腕部の表面部及び裏面部に形成され、

10

20

前記レジストパターン形成工程で、前記レジストパターンで成る前記表面部及び前記裏面部の前記短絡防止用間隔を調整するために、一の前記レーザを前記表面部及び裏面部に形成された前記レジストパターンに同時に照射することを特徴とする請求項1又は2記載の振動片の製造方法。

【請求項4】

前記振動腕部が略直方体であり、その表面部の短辺である腕部幅が50μm以上150μm以下であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の振動片の製造方法。

【請求項5】

前記振動腕部の表面部及び裏面部に溝部が形成されていると共に、前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して30%以上50%未満の深さに形成されていることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の振動片の製造方法。

10

【請求項6】

前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して40%以上50%未満の深さに形成されていることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の振動片の製造方法。

【請求項7】

前記溝部の開口における短辺である溝幅が、前記振動腕部の前記腕部幅の40%以上と成っていることを特徴とする請求項5に記載の振動片の製造方法。

20

【請求項8】

前記溝幅が前記腕部幅の70%以上100%未満に形成されていることを特徴とする請求項7に記載の振動片の製造方法。

【請求項9】

前記基部には、この振動片を固定させるための固定領域が設けられていると共に、前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられていることを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の振動片の製造方法。

【請求項10】

前記振動片が略30KHz乃至略40KHzで発振する水晶で形成されている音叉型振動片であることを特徴とする請求項1乃至請求項9のいずれかに記載の振動片の製造方法。

30

【請求項11】

切り込み部を有する基部と、

前記基部から突出して形成され、その表面部及び/又は裏面部に溝部が形成されている振動腕部を有し、

前記溝部内に溝電極が形成され、

前記振動腕部の側面に側面電極が形成されている振動片がパッケージ内に収容されている振動子の製造方法であって、

前記振動片に電極膜を形成する電極膜形成工程と、

前記溝電極と前記側面電極とをパターニングするためのレジストパターンを形成するレジストパターン形成工程と、

40

前記レジストパターン形成工程で前記レジストパターンにより形成された短絡防止用間隔を調整するために、前記レジストパターンの外形に対してレーザを照射するパターン形状調整工程と、

前記レジストパターンをマスクとして前記電極膜をエッチングし、前記溝電極と前記側面電極を形成する工程と、を有することを特徴とする振動子の製造方法。

【請求項12】

前記レーザがYAGレーザの3倍高調波を用いることを特徴とする請求項11に記載の振動子の製造方法。

【請求項13】

50

前記溝部が前記振動腕部の表面部及び裏面部に形成され、前記レジストパターン形成工程で、前記表面部及び前記裏面部に形成された前記レジストパターンで成る前記表面部及び前記裏面部の前記短絡防止用間隔を調整するために、同時に前記レーザを照射することを特徴とする請求項11又は請求項12に記載の振動子の製造方法。

【請求項14】

前記振動片の前記振動腕部が略直方体であり、その表面部の短辺である腕部幅が50μm以上150μm以下であることを特徴とする請求項11乃至請求項13のいずれかに記載の振動子の製造方法。

【請求項15】

前記振動片の前記振動腕部の表面部及び裏面部に溝部が形成されていると共に、前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して30%以上50%未満の深さに形成されていることを特徴とする請求項11乃至請求項14のいずれかに記載の振動子の製造方法。

10

【請求項16】

前記振動片の前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して40%以上50%未満の深さに形成されていることを特徴とする請求項11乃至請求項15のいずれかに記載の振動子の製造方法。

【請求項17】

前記振動片の前記溝部の開口における短辺である溝幅が、前記振動腕部の前記腕部幅の40%以上と成っていることを特徴とする請求項15に記載の振動子の製造方法。

20

【請求項18】

前記振動片の前記溝幅が前記腕部幅の70%以上100%未満に形成されていることを特徴とする請求項17に記載の振動子の製造方法。

【請求項19】

前記振動片の前記基部には、この振動片を固定させるための固定領域が設けられていると共に、前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられていることを特徴とする請求項11乃至請求項18のいずれかに記載の振動子の製造方法。

【請求項20】

前記振動片が略30KHz乃至略40KHzで発振する水晶で形成されている音叉振動片であることを特徴とする請求項11乃至請求項19のいずれかに記載の振動子の製造方法。

30

【請求項21】

前記パッケージが箱状に形成されていることを特徴とする請求項11乃至請求項20のいずれかに記載に振動子の製造方法。

【請求項22】

前記パッケージが所謂シリンダータイプに形成されていることを特徴とする請求項11乃至請求項20のいずれかに記載の振動子の製造方法。

【請求項23】

切り込み部を有する基部と、

40

前記基部から突出して形成され、その表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されている振動腕部を有し、

前記溝部内に溝電極が形成され、

前記振動腕部の側面に側面電極が形成されている振動片と集積回路がパッケージ内に収容されている発振器の製造方法であって、

前記振動片に電極膜を形成する電極膜形成工程と、

前記溝電極と前記側面電極とをパターニングするためのレジストパターンを形成するレジストパターン形成工程と、

前記レジストパターン形成工程で前記レジストパターンにより形成された短絡防止用間隔を調整するために、前記レジストパターンの外形に対してレーザを照射するパターン形

50

状調整工程と、

前記レジストパターンをマスクとして前記電極膜をエッチングし、前記溝電極と前記側面電極を形成する工程と、を有することを特徴とする発振器の製造方法。

【請求項 24】

切り込み部を有する基部と、

前記基部から突出して形成され、その表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されている振動腕部を有し、

前記溝部内に溝電極が形成され、

前記振動腕部の側面に側面電極が形成されている振動片であり、この振動片がパッケージ内に収容されている振動子であり、この振動子を制御部に接続して用いている電子機器の製造方法であって、 10

前記振動片に電極膜を形成する電極膜形成工程と、

前記溝電極と前記側面電極とをパターニングするためのレジストパターンを形成するレジストパターン形成工程と、

前記レジストパターン形成工程で前記レジストパターンにより形成された短絡防止用間隔を調整するために、前記レジストパターンの外形に対してレーザを照射するパターン形状調整工程と、

前記レジストパターンをマスクとして前記電極膜をエッチングし、前記溝電極と前記側面電極を形成する工程と、を有することを特徴とする電子機器の製造方法。

【発明の詳細な説明】

20

【技術分野】**【0001】**

本発明は、例えば水晶等からなる振動片の製造方法、この振動片を有する振動子の製造方法、この振動子を備える発振器の製造方法や電子機器の製造方法に関する。

【背景技術】**【0002】**

従来、振動片である音叉型水晶振動片は、例えば図12に示すように構成されている。

すなわち、音叉型水晶振動片10は、基部11と、この基部11から突出して形成されている2本の腕部12，13を有している。そして、この2本脳で部12，13には、溝12a，13aが表面に形成されている。また、この溝は図12の腕部12，13の裏面側にも同様に形成されている。 30

このため、図12のA-A'断面図である図13に示すように腕部12，13は、その断面形状が略H型の形成されている。

【0003】

このような略H型の音叉型水晶振動片10は、振動片の大きさを小型化しても、腕部12，13の振動損失が低くC I値(クリスタルインピーダンス又は等価直列抵抗)も低く抑えができるという特性を有する。

このため、略H型の音叉型水晶振動片10は、例えば特に小型でも高精度な性能が求められる振動子に適用されている。

略H型の音叉型水晶振動片10の大きさとしては、例えば図12に示すように腕部12，13の長さが1.644mm、幅が0.1mmとなっており、この腕部12，13に幅0.07mmの幅で溝12a，13aが形成されている。 40

さらに、基部11は図において縦方向の長さが0.7mmとなっている。

【発明の開示】**【発明が解決しようとする課題】****【0004】**

このように極めて小型の音叉型水晶振動片10であっても、近年の電気機器等の装置の小型化の要請に対応するには、更なる小型化が求められている。

この小型化の要請に対応するには、基部11の図12における縦方向の長さを0.7mmより短く形成すれば、全体として振動片10の長さが短くなり、振動片10が小型化さ 50

れ、最も良いのであるが、以下のような問題があった。

すなわち、一般に基部11の長さを腕部12, 13の長さの40%以上としないと、振動片の固定バラツキによる影響が出やすく振動片素子間のCI値バラツキの発生が生じやすいという問題があった。

具体的には、腕部12, 13の幅をW、腕部12, 13の長さをLとした場合、音叉型水晶振動片10の周波数fは、

$$f = W / L^2 \quad \dots \dots \dots \text{式1}$$

の関係式を満たさなければならない。すなわち、振動片10の腕部12, 13の長さLを短くすればするほど、腕部12, 13の幅Wも細くなるという関係になっている。

【0005】

図12に示す音叉型水晶振動片10は、上述のように小型化されているため腕部12, 13の長さLが1.644mmと短いため、その幅も0.1mmと極めて細くなっている。さらに腕部12, 13の厚みも0.1mmと成っている。

ところで、音叉型水晶振動片10の腕部12, 13は、図13(a)に示すように、幅Wが長く厚みDが短ければ、図において矢印Bに示すように通常の水平方向の振動を行うことになる。

しかし、上述のように幅Wが短くなると、図13(b)に示すように、垂直方向の成分(図において矢印Cの方向)を含むようになり、図13(b)において矢印Eで示す方向に腕部12, 13が振動するようになる。

これは、垂直振動成分変位量(nm)は、腕部12, 13の幅W/厚みDが1.2より小さくなると急激に変位量も大きくなることによる。

【0006】

このように腕部12, 13の振動の垂直成分が増加し、腕部12, 13が動くと、この振動が振動片10の基部11へと伝わり、振動片10をパッケージ等に固定する基部11の固定領域の接着剤等からエネルギーが逃げてしまうことになる。

このように振動が基部11へ漏れ、基部11の固定領域からエネルギーが逃げると、振動片の固定バラツキの影響によって、腕部12, 13の振動が振動片によっては不安定となるものが生じ、CI値の素子間のバラツキが大きくなっていた。

そして、このような腕部12, 13の振動の漏れや基部11の固定領域からのエネルギーの逃げを防ぐには、上述のように腕部12, 13の長さLの40%以上の長さを基部11において確保しなければならなかった。したがって、これが振動片10自体の小型化の障害となっていた。

【0007】

本発明は上記問題に鑑み、基部を短くしてもCI値の振動片素子間のバラツキが安定すると共に振動片全体も小型化できる振動片の製造方法、これを有する振動子の製造方法、この振動子を備える発振器の製造方法及び電子機器の製造方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

前記目的は、切り込み部を有する基部と、前記基部から突出して形成され、その表面部及び/又は裏面部に溝部が形成されている振動腕部を有し、前記溝部内に溝電極が形成され、前記振動腕部の側面に側面電極が形成されている振動片の製造方法であって、前記振動片に電極膜を形成する電極膜形成工程と、前記溝電極と前記側面電極とをパターニングするためのレジストパターンを形成するレジストパターン形成工程と、前記レジストパターン形成工程で前記レジストパターンにより形成された短絡防止用間隔を調整するために、前記レジストパターンの外形に対してレーザを照射するパターン形状調整工程と、前記レジストパターンをマスクとして前記電極膜をエッチングし、前記溝電極と前記側面電極を形成する工程と、を有することを特徴とする振動片の製造方法により、達成される。

【0009】

前記構成によれば、前記基部に切り込み部が形成されているので、振動腕部が振動する

10

20

30

40

50

際に、垂直方向成分を有した振動が生じても、振動腕部の振動が基部側へ漏れるのを、この切り込み部で緩和することができる。したがって、基部を小型化しながら、C I 値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

また、振動片の製造方法に用いる例えは、フォトレジストは、電極膜 150 上に塗布されるが、図 17 (a) の音叉腕 120 の角部であるエッジ部分 (図における矢印 E) をカバーするように塗布する必要がある。このとき、塗布するフォトレジストが粒子状になっていた方がエッジ部分 E のカバーが良い。

しかしながら、フォトレジストをこのように粒子状のものを含んだ状態で塗布すると、フォトレジスト現像後のフォトレジストパターン 152 の外形は正確な略直線ではなく、粒子の外形に沿った略波線に形成されてしまう。

このようにフォトレジストパターン 152 の外形線が、不均一であると前記短絡防止用間隔が例えば、15 μm という微細な間隔を形成する場合、部分的に間隔が保持されないおそれがある。

間隔が保持されない場合は、エッチングされない部分となってしまうため、溝電極と側面電極同士が短絡するおそれがある。

そのため、本発明では、前記レジストパターン形成工程で前記レジストパターンにより形成された短絡防止用間隔を調整するために、前記レジストパターンの外形に対してレーザを照射するパターン形状調整工程を有している。

すなわち、レーザをレジストパターンの一部の形状である短絡防止用間隔について照射される。

つまり、レジストパターンの外形線が不均一となり、レジストパターンをマスクとしてエッチングした場合、形成される溝電極と側面電極とが短絡等を生じないように、短絡防止用間隔が確保できるように、レジストパターンの外形がレーザによって調整される。

したがって、レジストパターンがレーザによって正確に形成された後、前記レジストパターンをマスクとして前記電極膜をエッチングし、前記溝電極と前記側面電極を形成する工程を行えば、短絡防止用間隔を正確に確保することができる。

以上のようにして製造された振動片は、振動腕部の例えは、腕表面及び腕裏面の短絡防止用間隔 W1 が例えは 15 μm に正確保持され、溝電極と側面電極とが短絡等することを有効に防止することができ、不良が生じにくい振動片となる。

また、レジストパターンを形成してからレーザを照射するので、特に例えはフォトレジストの感光を防止するイエロールーム内でレーザを照射する必要がないので製造コストを低減することができる。

【 0010 】

好ましくは、前記レーザが YAG レーザの 3 倍高調波を用いている。

【 0011 】

前記構成によれば、YAG レーザを用いているので、レジストパターンの外形をより正確に調整することができる。

【 0012 】

好ましくは、記溝部が前記振動腕部の表面部及び裏面部に形成され、前記レジストパターン形成工程で、前記表面部及び前記裏面部に形成された前記レジストパターンで成る前記表面部及び前記裏面部の前記短絡防止用間隔を調整するために、同時に前記レーザを照射する。

【 0013 】

前記構成によれば、レジストパターンで成る表面部及び裏面部の短絡防止用間隔を調整するために、同時にレーザを照射するので、表面部と裏面部の両方の調整を同時にできる。このため、振動片の生産工程を減らすことができるので生産コストを下げるこができる。

【 0014 】

好ましくは、前記振動腕部が略直方体であり、その表面部の短辺である腕部幅が 50 μm 以上 150 μm 以下である。

10

20

30

40

50

【0015】

前記振動腕部が略直方体でなり、その表面部の短辺である腕部幅が50μm以上150μm以下である。このような振動片においても、前記切り込み部を設けることで、基部を小型化でき、振動片全体を超小型化できると共に、実用的なC I値の上限である100K以下で、C I値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

【0016】

好ましくは、前記振動腕部の表面部及び裏面部に溝部が形成されていると共に、前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して30%以上50%未満の深さに形成されている。

【0017】

前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して30%以上50%未満の深さに形成されているので、超小型振動片でもC I値を実用上の上限である100K以下に抑えることができる。また、前記切り込み部を設けることで、C I値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

【0018】

好ましくは、前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して40%以上50%未満の深さに形成されている。

【0019】

前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して40%以上50%未満の深さに形成されているので、超小型振動片でもC I値を実用上の上限である100K以下により精度良く抑えることができる。

【0020】

好ましくは、前記溝部の開口における短辺である溝幅が、前記振動腕部の前記腕部幅の40%以上と成っている。

【0021】

前記溝部の開口における短辺である溝幅が、前記振動腕部の前記腕部幅の40%以上と成っているので、C I値を実用上の上限である100K以下に抑えることができる。また、前記切り込み部を設けることで、C I値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

【0022】

好ましくは、前記溝幅が前記腕部幅の70%以上100%未満に形成されている。

【0023】

前記溝幅が前記腕部幅の70%以上100%未満に形成されているので、前記切り込み部を設けることで、C I値の振動片素子間のバラツキをより安定化させることができる。

【0024】

好ましくは、前記基部には、この振動片を固定させるための固定領域が設けられていると共に、前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられている。

【0025】

前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられている。したがって、この切り込み部は、前記振動腕部の振動の妨げにならない位置に配置されていると共に、振動漏れが前記固定領域へ伝わり、エネルギーの逃げが生じるのを有効に防止している。このため、C I値の振動片素子間のバラツキが安定化する。

【0026】

好ましくは、前記振動片が略30KHz乃至略40KHzで発振する水晶で形成されている音叉振動片である。

【0027】

10

20

30

40

50

前記振動片が略30KHz乃至略40KHzで発振する水晶で形成されている音叉型振動片に前記切り込み部を設けることで、基部を小型化でき、音叉型振動片全体も小型化でき、C I値の振動片素子間のバラツキも安定化させることができる。

【0028】

前記目的は、切り込み部を有する基部と、前記基部から突出して形成され、その表面部及び/又は裏面部に溝部が形成されている振動腕部を有し、前記溝部内に溝電極が形成され、前記振動腕部の側面に側面電極が形成されている振動片がパッケージ内に収容されている振動子の製造方法であって、前記振動片に電極膜を形成する電極膜形成工程と、

前記溝電極と前記側面電極とをパターニングするためのレジストパターンを形成するレジストパターン形成工程と、前記レジストパターン形成工程で前記レジストパターンにより形成された短絡防止用間隔を調整するために、前記レジストパターンの外形に対してレーザを照射するパターン形状調整工程と、前記レジストパターンをマスクとして前記電極膜をエッチングし、前記溝電極と前記側面電極を形成する工程と、を有することを特徴とする振動子の製造方法により達成される。

【0029】

好ましくは、前記レーザがYAGレーザの3倍高調波を用いる振動子の製造方法。

【0030】

好ましくは、前記溝部が前記振動腕部の表面部及び裏面部に形成され、前記レジストパターン形成工程で、前記表面部及び前記裏面部に形成された前記レジストパターンで成る前記表面部及び前記裏面部の前記短絡防止用間隔を調整するために、同時に前記レーザを照射する振動子の製造方法。

【0031】

好ましくは、前記振動片の前記振動腕部が略直方体であり、その表面部の短辺である腕部幅が50μm以上150μm以下である。

【0032】

好ましくは、前記振動片の前記振動腕部の表面部及び裏面部に溝部が形成されていると共に、前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して30%以上50%未満の深さに形成されている振動子の製造方法。

【0033】

好ましくは、前記振動片の前記表面部又は前記裏面部に設けられている溝部のいずれかの深さが、前記振動腕部の深さ方向の全長である厚みに対して40%以上50%未満の深さに形成されている振動子の製造方法。

【0034】

好ましくは、前記振動片の前記溝部の開口における短辺である溝幅が、前記振動腕部の前記腕部幅の40%以上と成っている振動子の製造方法。

【0035】

好ましくは、前記振動片の前記溝幅が前記腕部幅の70%以上100%未満に形成されている振動子の製造方法。

【0036】

好ましくは、前記振動片の前記基部には、この振動片を固定させるための固定領域が設けられていると共に、前記切り込み部は、この固定領域と前記振動腕部との間の基部に設けられている振動子の製造方法。

【0037】

好ましくは、前記振動片が略30KHz乃至略40KHzで発振する水晶で形成されている音叉振動片である振動子の製造方法。

【0038】

好ましくは、前記パッケージが箱状に形成されている振動子の製造方法。

【0039】

前記パッケージが箱状に形成されている振動子を小型化でき、前記振動片のC I値の振

10

20

30

40

50

動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

【0040】

好ましくは、前記パッケージが所謂シリンダータイプに形成されている振動子の製造方法

。

【0041】

前記パッケージが所謂シリンダータイプに形成されている振動子や振動片を小型化でき、前記振動片のC I値の振動片素子間のバラツキを安定化させることができる。

【0042】

前記目的は、切り込み部を有する基部と、前記基部から突出して形成され、その表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されている振動腕部を有し、前記溝部内に溝電極が形成され、前記振動腕部の側面に側面電極が形成されている振動片と集積回路がパッケージ内に収容されている発振器の製造方法であって、前記振動片に電極膜を形成する電極膜形成工程と、前記溝電極と前記側面電極とをパターニングするためのレジストパターンを形成するレジストパターン形成工程と、前記レジストパターン形成工程で前記レジストパターンにより形成された短絡防止用間隔を調整するために、前記レジストパターンの外形に対してレーザを照射するパターン形状調整工程と、前記レジストパターンをマスクとして前記電極膜をエッチングし、前記溝電極と前記側面電極を形成する工程と、を有することを特徴とする発振器の製造方法により達成される。

10

【0043】

前記目的は、切り込み部を有する基部と、前記基部から突出して形成され、その表面部及び／又は裏面部に溝部が形成されている振動腕部を有し、前記溝部内に溝電極が形成され、前記振動腕部の側面に側面電極が形成されている振動片であり、この振動片がパッケージ内に収容されている振動子であり、この振動子を制御部に接続して用いている電子機器の製造方法であって、前記振動片に電極膜を形成する電極膜形成工程と、前記溝電極と前記側面電極とをパターニングするためのレジストパターンを形成するレジストパターン形成工程と、前記レジストパターン形成工程で前記レジストパターンにより形成された短絡防止用間隔を調整するために、前記レジストパターンの外形に対してレーザを照射するパターン形状調整工程と、前記レジストパターンをマスクとして前記電極膜をエッチングし、前記溝電極と前記側面電極を形成する工程と、を有することを特徴とする電子機器の製造方法により達成される。

20

【発明の効果】

【0044】

以上説明したように、本発明によれば、基部を短くしてもC I値の振動片素子間のバラツキが安定すると共に振動片全体も小型化できる振動片の製造方法、これを有する振動子の製造方法、この振動子を備える発振器の製造方法及び電子機器の製造方法を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0045】

以下、本発明の好適な実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。

なお、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの形態に限られるものではない。

40

(第1の実施の形態)

図1は、本発明の第1の実施の形態に係る振動片である音叉型水晶振動片100を示す図である。

音叉型水晶振動片100は、例えば所謂水晶Z板となるように水晶の単結晶を切り出して形成されている。また、図1に示す音叉型水晶振動片100は例えば32.768KHzで信号を発信する振動片であるため、極めて小型の振動片となっている。

このような音叉型水晶振動片100は、図1に示すように、基部110を有している。そして、この基部110から図において上方向に突出するように振動腕部である音叉腕1

50

21, 122が2本配置されている。

また、この音叉腕121, 122の表面と裏面には、溝部123, 124が図1に示すように形成されている。この溝部123, 124は、図1に示されていない音叉腕121, 122の裏面側にも同様に形成されているため、図2に示すように図1のF-F'断面図では、略H型に形成されている。

【0046】

ところで、上記音叉型水晶振動片100の基部110は、その全体が略板状に形成されている。そして、図において縦方向の長さが、例えば0.56mmに形成されている。

一方、この基部110から突出して配置されている前記音叉腕121, 122の図において縦方向の長さは例えば1.644mmに形成されている。

10

したがって、この音叉腕121, 122に対する基部110の長さは、約34%となっている。これに対して従来の音叉型水晶振動片10は、図12に示すように基部11の長さが0.7mmで腕部12, 13の長さが1.644mmに形成され、基部11の長さは腕部12, 13の長さに対して約42.6%となり、40%を超えてい。

このように基部11の長さを腕部12, 13の長さに対して40%以上の長さになるようにすることで、上述のように腕部12, 13の振動による振動漏れで生じるCI値の振動片素子間のバラツキの増大を防いでいるものである。

【0047】

これに対して、本実施の形態の音叉型水晶振動片100の基部110の長さは、音叉腕121, 122の長さに対して上述のように34%になるように形成されているので、従来の音叉型水晶振動片10と同様の構成では、音叉腕121, 122の振動による振動漏れが生じ、CI値の振動片素子間のバラツキが増大することになる。

20

しかし、本実施の形態では、図1に示すように基部110の両側に切り込み部125が2箇所設けられている。

この状態を示すのが図3である。図3は図1の基部110の切り込み部125の配置状態を示す概略斜視図である。

図3に示すように切り込み部125が矩形状に形成されされている。

このような切り込み部125は、図1に示すように基部110の上端部から0.113mm下側から下方に向かって形成されている。

【0048】

30

この切り込み部125の基部110における配置条件を示したのが図4である。図4において基部110の底面から基部110の上端、具体的には2本の音叉腕121, 122の間の股部までの長さをA1とする。

そして、基部110の底面から切り込み部125の上端部までの長さをA2とする。

また、基部110の底面から音叉腕121, 122に形成されている溝部123, 124の下端部までの長さをA3としたとき、A3の長さは、A2の長さより長くなるように切り込み部125が形成される。

そして、A3の長さはA1の長さと同じか、若しくはA3の長さがA1の長さより長くなるように形成される。したがって、音叉腕121, 122の根元より基部110の底面側に前記溝部123, 124が形成されないようになっている。

40

【0049】

以上の関係から、基部110に形成される切り込み部125の位置は、必ず音叉腕121, 122の溝部123, 124の下端部より下方に配置されることになる。

したがって、この切り込み部125の存在が、音叉腕部121, 122の振動を阻害等する事がない。

また、図4で斜線で示す部分は、音叉型水晶振動片100をパッケージにおいて固定する際に実際に固定される固定領域111である。この固定領域111の上端部と、基部110の底面との長さを示したのがA4である。

そして、この固定領域111と切り込み部125との位置関係は、A2の長さが、必ずA4の長さより長くなる。

50

したがって、切り込み部 125 の上端部は、必ず固定領域 111 より図 4 の上方に配置されるので、切り込み部 125 が固定領域 111 に影響を及ぼすことがなく、音叉型水晶振動片 100 のパッケージに対する固定状態に悪影響を与えることがない。

【0050】

このように、基部 110 に設けられた切り込み部 125 は、音叉型水晶振動片 100 の音叉腕 121, 122 の振動に悪影響を与えることがない位置に設けられている。そして、更に、切り込み部 125 は、音叉型水晶振動片 100 のパッケージに対する固定状態に悪影響を与えることがない位置にも設けられている。

このような位置に設けられている切り込み部 125 は、音叉腕 121, 122 の溝部 123, 124 の位置より下方の基部 110 側に設けられている。そのため、音叉腕 121, 122 の振動により、溝部 123, 124 から漏れてきた漏れ振動は、切り込み部 125 により、基部 110 の固定領域 111 に伝わり難くなる。10

したがって、漏れ振動が固定領域 111 に伝わり、エネルギー逃げが生じ難くなり、従来の CI 値の振動片素子間のばらつきは、標準偏差で 10K 以上発生していたが、これによって、標準偏差は 1K に激減した。

【0051】

以上のように CI 値の振動片素子間のバラツキの安定化を図ることができるので、従来の音叉型水晶振動片 10 のように基部 11 の長さを腕部 12, 13 の長さの 40% 以上にする必要がない。

本実施の形態では、図 1 に示すように、音叉型水晶振動片 100 の基部 110 の長さは、音叉腕 121, 122 の長さに対して上述のように 34% になるように形成されていても、音叉腕 121, 122 の振動による振動漏れが生じ難く CI 値の振動片素子間のバラツキが安定化することになる。これにより、基部 110 の長さを短くすることができ、音叉型水晶振動片 100 の大きさを小型化することができる。20

本実施の形態では、基部 110 の長さが図 1 に示すように 0.56mm とすることができます、従来の音叉型水晶振動片 10 の図 12 に示す基部 11 の長さである 0.7mm より著しく小さくすることが可能となる。

【0052】

このように構成される基部 110 に突出して形成されるのが、図 1 に示す音叉腕 121, 122 である。30

この音叉腕 121, 122 のそれぞれの幅は、図 1 に示すように 0.1mm に形成される。このように音叉腕 121, 122 の腕幅を著しく狭くするのは、上述の式 1 である「 $f = W / L^2$ 」の説明で詳述したように、音叉腕 121, 122 の長さ (L) を短くしたためである。

すなわち、音叉腕 121, 122 の長さを図 1 に示すように 1.644mm と短くするには、上記式 1 から腕幅は、0.1mm にする必要があり、そのため腕幅を 0.1mm としたものである。

しかし、このように音叉腕 121, 122 の腕幅を 0.1mm とすると、CI 値が大きくなるおそれがある。

そこで、本実施の形態では、CI 値の上昇を抑えるために図 1 に示すように音叉腕 121, 122 の表面及び裏面に溝部 123, 124 が設けられている。40

【0053】

図 5 は溝幅が腕幅の 70% である場合の音叉腕 121, 122 の幅と CI 値との関係を示す図である。図 5 に示すように 2 点鎖線で示す溝部を設けていない音叉腕は、腕幅が 0.15mm より狭くなると実用的な CI 値である 100K を超え、実用に耐えない音叉型水晶振動子となる。

しかし、本実施の形態の音叉型水晶振動片 100 は、図 1 に示すように音叉腕の 121, 122 の表面及び裏面に溝部 123, 124 を設けているので、図 5 に示すように音叉腕 123, 124 の腕幅が 0.1mm でも実用的な CI 値である 100K 以内に収まり、実用的な振動片となる。50

また、図5では、溝部の深さを音叉腕121, 122の厚み方向に対して45%以内に収めれば、腕幅が0.05mmであっても、振動片のCI値は実用的なCI値である100K以内に収まることになる。

【0054】

このように、音叉腕121, 122の表面及び裏面に溝部123, 124を設けることで、CI値の上昇を抑えることができるが、この溝部123, 124の深さは、音叉腕121, 122の厚みの30%以上50%未満である必要がある。

図6は、溝幅が腕幅の70%である場合の溝深さ(片側面)とCI値との関係を示す図である。図6に示すように溝部123, 124の深さが音叉腕121, 122の厚みの30%以上50%未満であればCI値が実用的な100K以内に収まることになる。

10

一方、溝部123, 124の深さを50%以上にすると、溝部123, 124が音叉腕121, 122の表面及び裏面に設けられるため、貫通孔となり、周波数が所望の周波数と異なるところで発振することになってしまう。

ところで、図6に示すように溝部123, 124の深さを40%以上50%未満とすれば、CI値は実用的な100K内に収まるだけでなく、CI値は安定することになる。

本実施の形態の溝部123, 124は、音叉腕121, 122の厚み方向の45%である0.045mmとしている。

【0055】

更に、本実施の形態では、音叉腕121, 122の表面及び裏面に設けられた溝部123, 124の溝幅を0.07mmとしている。この溝幅0.07mmは、音叉腕121, 122の腕幅0.1mmの70%となっている。

20

この腕幅に対する溝幅の割合と、CI値との関係を示したのが図7である。図7に示すように、溝幅が腕幅の40%以上であれば、実用的なCI値である100K内に収まることになる。

そして、溝幅が腕幅の70%以上に形成されれば、図7に示すように、CI値の振動片素子間のバラツキは安定化することになる。

【0056】

以上のように構成される本実施の形態の音叉型水晶振動片100には、図示しない電極等が所定の位置に配置され、パッケージ等内に配置され、電圧が印加されると、音叉腕121, 122が振動するが、このとき、音叉腕121, 122の腕幅と厚みは、上述のように共に0.1mmに形成されている。

30

したがって、図13(b)に示すように垂直成分の振動が加わり、音叉腕121, 122が振動するが、この振動が基部110の切り込み部125で緩和され、エネルギーが基部110の固定領域111から逃げ、振動漏れが生じ、CI値の振動片素子間のバラツキが増大するのを未然に防止することができる。

また、この切れ込み部125は音叉腕121, 122の振動を阻害せず、且つ基部110の固定領域111の固定に影響を与えない基部110の部分に配置されているため、音叉腕121, 122の振動や音叉型水晶振動片100のパッケージに対する固定に悪影響を与えることがない。

【0057】

40

さらに、基部110の長さを従来の振動片より短くすることができるので、音叉型水晶振動片100の小型化を図ることができ、このような振動片を搭載する振動子等の小型化を可能にするものである。

そして、小型化された音叉型水晶振動片100は、実用的なCI値である100K以内に収まっているだけでなく、CI値の振動片素子間のバラツキが安定化するように溝部123, 124の深さや溝幅を調整しているので、より精度の高い超小型振動片となる。

【0058】

(第2の実施の形態)

図8は、本発明の第2の実施の形態に係る振動子であるセラミックパッケージ音叉型振動子200を示す図である。

50

このセラミックパッケージ音叉型振動子 200 は、上述の第 1 の実施の形態の音叉型水晶振動片 100 を用いている。したがって、音叉型水晶振動片 100 の構成、作用等については、同一符号を用いて、その説明を省略する。

図 8 は、セラミックパッケージ音叉型振動子 200 の構成を示す概略断面図である。図 8 に示すようにセラミックパッケージ音叉型振動子 200 は、その内側に空間を有する箱状のパッケージ 210 を有している。

このパッケージ 210 には、その底部にベース部 211 を備えている。このベース部 211 は、例えばアルミナ等のセラミックス等で形成されている。

【0059】

ベース部 211 上には、封止部 212 が設けられており、この封止部 212 は、ベース部 211 と同様の材料から形成されている。また、この封止部 212 の上端部には、蓋体 213 が載置され、これらベース部 211 、封止部 212 及び蓋体 213 で、中空の箱体を形成することになる。10

このように形成されているパッケージ 210 のベース部 211 上にはパッケージ側電極 214 が設けられている。このパッケージ側電極 214 の上には導電性接着剤等を介して音叉型水晶振動片 100 の基部 110 の固定領域 111 が固定されている。

この音叉型水晶振動片 100 は、図 1 に示すように構成されているため、小型で C I 値の振動片素子間のバラツキが安定しているので、この振動片を搭載したセラミックパッケージ音叉型振動子 200 も小型で C I 値の振動片素子間のバラツキが安定した高性能な振動子となる。20

【0060】

(第 3 の実施の形態)

図 9 は、本発明の第 3 の実施の形態に係る電子機器である携帯電話装置であるデジタル携帯電話 300 を示す概略図である。

このデジタル携帯電話 300 は、上述の第 2 の実施の形態のセラミックパッケージ音叉型振動子 200 と音叉型水晶振動片 100 とを使用している。

したがって、セラミックパッケージ音叉型振動子 200 と音叉型水晶振動片 100 の構成、作用当については、同一符号を用いる等して、その説明を省略する。

図 9 はデジタル携帯電話 300 の回路ブロックを示しているが、図 9 に示すように、デジタル携帯電話 300 で送信する場合は、使用者が、自己の声をマイクロフォンに入力すると、信号はパルス幅変調・符号化のブロックと変調器 / 復調器のブロックを経てトランシミッター、アンテナスイッチを開始アンテナから送信されることになる。30

【0061】

一方、他人の電話から送信された信号は、アンテナで受信され、アンテナスイッチ、受信フィルターを経て、レシーバーから変調器 / 復調器ブロックに入力される。そして、変調又は復調された信号がパルス幅変調・符号化のブロックを経てスピーカーに声として出力されるようになっている。

このうち、アンテナスイッチや変調器 / 復調器ブロック等を制御するためのコントローラが設けられている。

このコントローラは、上述の他に表示部である LCD や数字等の入力部であるキー、更には RAM や ROM 等も制御するため、高精度であることが求められる。また、デジタル携帯電話 300 の小型化の要請もある。40

このような要請に合致するものとして上述のセラミックパッケージ音叉振動子 200 が用いられている。

【0062】

このセラミックパッケージ音叉型振動子 200 は、図 1 に示す音叉型水晶振動片 100 を有するため、C I 値の振動片素子間のバラツキが安定し高精度となると共に、小型となる。したがって、このセラミックパッケージ音叉型振動子 200 を搭載したデジタル携帯電話 300 も小型で C I 値の振動片素子間のバラツキが安定した高性能なデジタル携帯電話となる。50

【0063】

(第4の実施の形態)

図10は、本発明の第4の実施の形態に係る発振器である音叉水晶発振器400を示す図である。

このデジタル音叉水晶発振器400は、上述の第2の実施の形態のセラミックパッケージ音叉型振動子200と多くの部分で構成が共通している。したがって、セラミックパッケージ音叉型振動子200と音叉型水晶振動片100の構成、作用等については、同一符号を用いて、その説明を省略する。

【0064】

図10に示す音叉型水晶発振器400は、図8に示すセラミックパッケージ音叉振動子200の音叉型水晶振動片100の下方で、ベース部211の上に、図10に示すように集積回路410を配置したものである。10

すなわち、音叉水晶発振器400では、その内部に配置された音叉型水晶振動片100が振動すると、その振動は、集積回路410に入力され、その後、所定の周波数信号を取り出すことで、発振器として機能することになる。

すなわち、音叉水晶発振器400に収容されている音叉型水晶振動片100は、図1に示すように構成されているため、小型でC/I値の振動片素子間のバラツキが安定しているので、この振動片を搭載したデジタル音叉水晶発振器400も小型でC/I値の振動片素子間のバラツキが安定した高性能な発振器となる。20

【0065】

(第5の実施の形態)

図11は、本発明に第5の実施の形態に係る振動子であるシリンダータイプ音叉振動子500を示す図である。

このシリンダータイプ音叉振動子500は、上述の第1の実施の形態の音叉型水晶振動片100を使用している。したがって、音叉型水晶振動片100の構成、作用等については、同一符号を用いる等して、その説明を省略する。

図11は、シリンダータイプ音叉振動子500の構成を示す概略図である。

図11に示すようにシリンダータイプ音叉振動子500は、その内部に音叉型水晶振動片100を収容するための金属製のキャップ530を有している。このキャップ530は、ステム520に対して圧入され、その内部が真空状態に保持されるようになっている。30

【0066】

また、キャップ530に収容された略H型の音叉型水晶振動片100を保持するためのリード510が2本配置されている。

このようなシリンダータイプ音叉振動子500に外部より電流等を印加すると音叉型水晶振動片100の音叉腕121, 122が振動し、振動子として機能することになる。

このとき、音叉型水晶振動片100は、図1に示すように構成されているため、小型でC/I値の振動片素子間のバラツキが安定しているので、この振動片を搭載したシリンダータイプ音叉振動子500も小型でC/I値の振動片素子間のバラツキが安定した高性能な振動子となる。

【0067】

また、上述の各実施の形態では、32.738KHzの音叉型水晶振動子を例に説明したが、15KHz乃至155KHzの音叉型水晶振動子に適用できることは明らかである。

なお、上述の実施の形態に係る音叉型水晶振動片100は、上述の例のみならず、他の電子機器、携帯情報端末、さらに、テレビジョン、ビデオ機器、所謂ラジカセ、パーソナルコンピュータ等の時計内蔵機器及び時計にも用いられることは明らかである。

【0068】

本実施の形態に係る音叉型水晶振動片100は、以上のように構成されるが、以下の製造方法等について説明する。

先ず、水晶基板をエッチング等することで、図14の電極が形成されていない状態の音叉型水晶振動片が形成される。その後、この音叉型水晶振動片に電極を形成する。40

以下、電極の形成工程を音叉腕120, 130を中心に説明する。また、音叉腕130は音叉腕120と同様のため、以下の説明は、音叉腕120の説明のみとする。図16は電極形成工程を示す概略フローチャートである。図17は、音叉腕120に電極が形成される工程を示す概略図である。

【0069】

先ず、図17(a)は、上記エッチングにより外形が形成された状態の音叉型水晶振動片の音叉腕120の図14のB-B'線概略断面図である。図17(a)に示すように、音叉腕120の表面120e及び裏面120fには、溝部120a、120aが形成される(溝部形成工程)。このような音叉腕120等を含む振動片全体にスパッタ等により金属膜である電極膜150を形成する(金属膜形成工程、図16のST1)。この状態を示したのが図17(b)である。図17に示す電極膜150は、下層がCrで厚みが例えば100乃至1000で形成される。そして、上層がAuで厚みが例えば500乃至1000で形成されている。

【0070】

このように表面全体に電極膜150を形成した後、図16のST2に示すようにフォトレジストを霧状に噴霧して電極膜150の上の全面に塗布する。すなわち、図17(c)に示すようにフォトレジスト膜151を形成する(フォトレジスト層形成工程)。

このフォトレジストは紫外光に感光感度を持つ樹脂をベースとした化合物であり、流動性を有するため、例えばスプレーにより霧状に噴霧して塗布される。

また、フォトレジスト膜151の厚みは、例えば1μm乃至6μmとなっている。

【0071】

次に、図16のST3に示すようにフォトレジストパターン形成を行う。すなわち、図14の電極形成部分(斜線部分)を除く部分を覆うような図示しないマスクを介して紫外線をフォトレジスト膜151に照射して(露光)、現像液で取り除き、加熱工程等を経てフォトレジスト膜151を固化させる。

これにより、図14の電極形成部分(斜線部分)に対応する形状のフォトレジストパターン152が形成される。

【0072】

このとき、フォトレジストパターン152は、図14及び図15の短絡防止用間隔W1、具体的は例えば15μmの幅でフォトレジスト膜151が形成されていない部分ができる。

ところで、フォトレジストは、上述のように電極膜150上に塗布されるが、図17(a)の音叉腕120の角部であるエッジ部分(図における矢印E)をカバーするように塗布する必要がある。このとき、塗布するフォトレジストが粒子状になっていた方がエッジ部分Eのカバーが良い。

しかしながらフォトレジストをこのように粒子状のものを含んだ状態で塗布すると、フォトレジスト現像後のフォトレジストパターン152の外形は正確な略直線ではなく、粒子の外形に沿った略波線に形成されてしまう。

このようにフォトレジストパターン152の外形線が、不均一であると前記短絡防止用間隔W1が15μmという微細な間隔を形成する場合、部分的に間隔が保持されないおそれがある。

間隔が保持されていない部分は、エッチングされない部分となってしまうため、電極同士の短絡等のおそれがある。

【0073】

そのため、本実施の形態では、図16のST4に示すようにレーザ照射を行う(パターン形状調整工程)。具体的には、前記フォトレジストパターン152の一部の形状である図14の音叉腕120の腕表面120eの短絡防止用間隔W1について行われる。

すなわち、図18(a)に示すように、フォトレジストパターン152の外形線が不均一となり、このフォトレジストパターンをマスクとしてエッチングした場合、形成される溝電極120bと側面電極120dとが短絡等を生じないように、短絡防止用間隔W1が

10

20

30

40

50

例えば $15\text{ }\mu\text{m}$ 確保できるようにフォトレジストパターン152の外形がレーザによって調整される。

【0074】

このレーザは、例えば、YAGレーザ等が用いられ、特にYAGレーザの3倍高調波を用いるとフォトレジストパターン152の外形をより正確に調整することができる。このようにフォトレジストパターン152を形成してからレーザを照射するので、特にフォトレジストの感光を防止するイエロールーム内でレーザを照射する必要がないので製造コストを低減することができる。また、レーザの照射は、図18(a)(b)に示すように音叉腕120の腕表面120eの短絡防止用間隔W1と腕裏面120fの短絡防止用間隔W1とを別々に行う。

10

【0075】

しかし、これに限らず図18(c)に示すように腕表面120e及び腕裏面の120fの双方を同時にレーザによって加工することもできる。

この場合、生産工程を減らすことができるので生産コストも下げることができる

【0076】

このようにフォトレジストパターン152がレーザによって正確に形成された後、図16のST5のエッチング工程となる(電極膜形成工程)。

具体的には、上述のフォトレジストパターン152をマスクとして電極膜150をエッチングにより除去する。

図19(a)は、エッチングにより電極膜150が除去された状態を示す図である。図19(b)に示すように本実施の形態の製造方法によれば、短絡防止用間隔W1を正確に確保することができる。

20

【0077】

次に、図16のST6のレジスト剥離工程でフォトレジストパターン152を除去すれば、図19(b)に示すように溝電極120b、側面電極120dが正確に形成されることになる(フォトレジストパターン剥離工程)。

このとき、上述のレーザ照射工程(ST3)の図17に示すレーザ照射で電極膜150の一部が溶解し、この溶解した電極膜150の一部がレジストパターン152と共に除去されるので、より正確に短絡防止用間隔W1を形成することができる。

そして、このとき、音叉型水晶振動片100全体については、図14に示すように基部電極140a等が所定の形状で形成され、音叉型水晶振動片100の電極配置が終了する。

30

このようにして製造された音叉型水晶振動片100は、音叉腕120、130の腕表面120e、130e及び腕裏面120f、130fの短絡防止用間隔W1が例えば $15\text{ }\mu\text{m}$ に正確保持され、溝電極120b、130bと側面電極120d、130dとが短絡等することを有効に防止することができ、不良が生じにくい音叉型水晶振動片となる。

【0078】

以上説明したように、本発明によれば、基部を短くしてもCI値の振動片素子間のバラツキが安定すると共に振動片全体も小型化できる振動片を有する振動子、この振動子を備える発振器及び電子機器を提供することができる。

40

【図面の簡単な説明】

【0079】

【図1】本発明に第1の実施の形態に係る音叉型水晶振動片の概略図である。

【図2】図1のF-F'線断面図である。

【図3】図1の基部の切り込み部の構成を示す概略斜視図である。

【図4】図1の音叉型水晶振動子の説明図である。

【図5】音叉腕幅とCI値との関係を示す図である。

【図6】溝深さとCI値との関係を示す図である。

【図7】音叉腕幅に対する溝幅の割合とCI値との関係を示す図である。

【図8】本発明の第2の実施の形態に係るセラミックパッケージ音叉型振動子の構成を示す図である。

50

す概略断面図である。

【図9】本発明の第3の実施の形態に係るデジタル携帯電話の回路プロックを示す概略図である。

【図10】本発明の第4の実施の形態に係る音叉水晶発振器の構成を示す概略断面図である。

【図11】本発明の第5の実施の形態に係るシリンダータイプ音叉振動子の構成を示す概略断面図である。

【図12】従来の音叉型水晶振動片を示す概略図である。

【図13】(a)腕部の振動の説明図である。(b)腕部の振動の他の説明図である。

【図14】本発明の第1の実施の形態に係る振動片の製造方法で製造された音叉型水晶振動片100を示す概略図である。 10

【図15】図14のB-B'線概略断面図である。

【図16】電極形成工程を示す概略フローチャートである。

【図17】音叉腕に電極が形成される工程を示す概略図である。

【図18】音叉腕に電極が形成される他の工程を示す概略図である。

【図19】音叉腕に電極が形成される他の工程を示す概略図である。

【符号の説明】

【0080】

100・・・音叉型水晶振動片

110・・・基部

20

111・・・固定領域

121、122・・・音叉腕

123、124・・・溝部

125・・・切り込み部

200・・・セラミックパッケージ音叉振動子

210・・・パッケージ

211・・・ベース部

212・・・側面部

213・・・蓋体

214・・・パッケージ側電極

30

300・・・デジタル携帯電話

400・・・音叉水晶発振器

410・・・集積回路

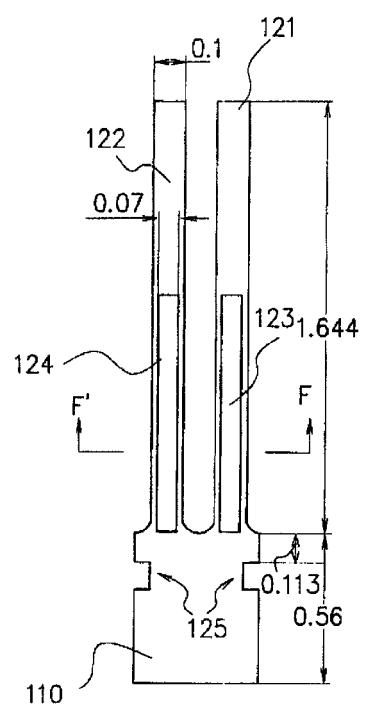
500・・・シリンダータイプ音叉振動子

510・・・リード

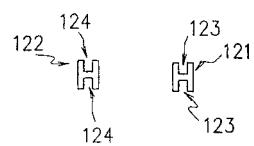
520・・・ステム

530・・・キャップ

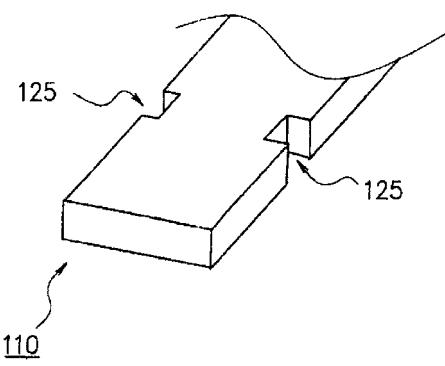
【図1】



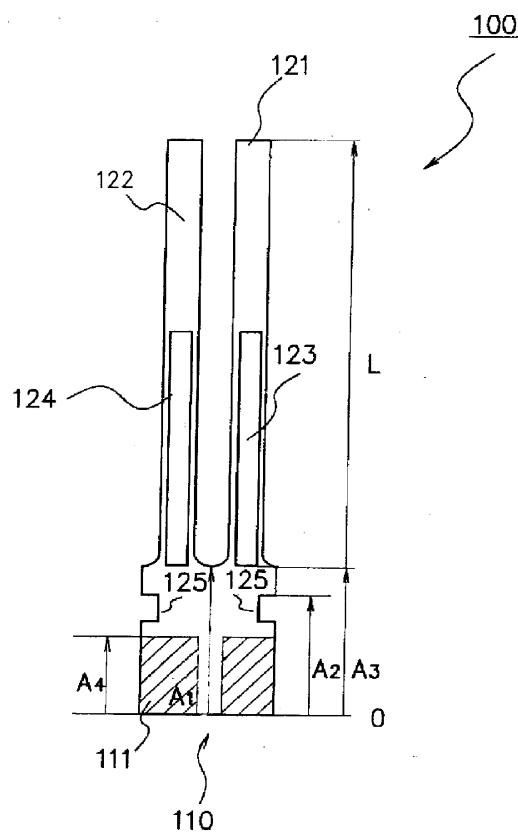
【図2】



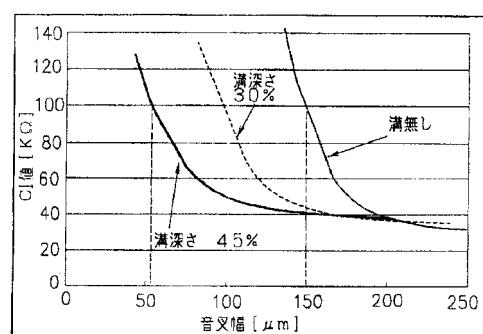
【図3】



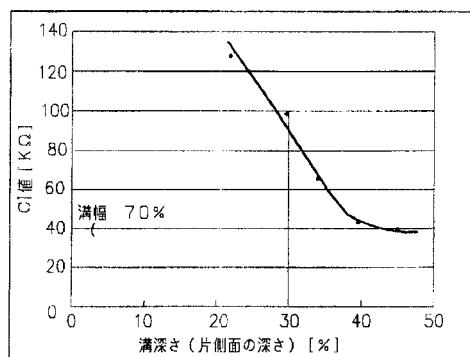
【図4】



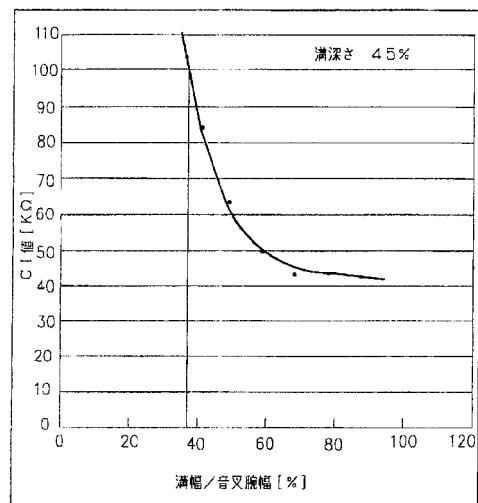
【図5】



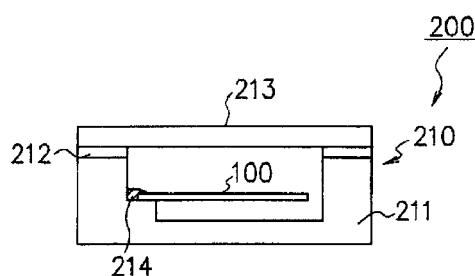
【図 6】



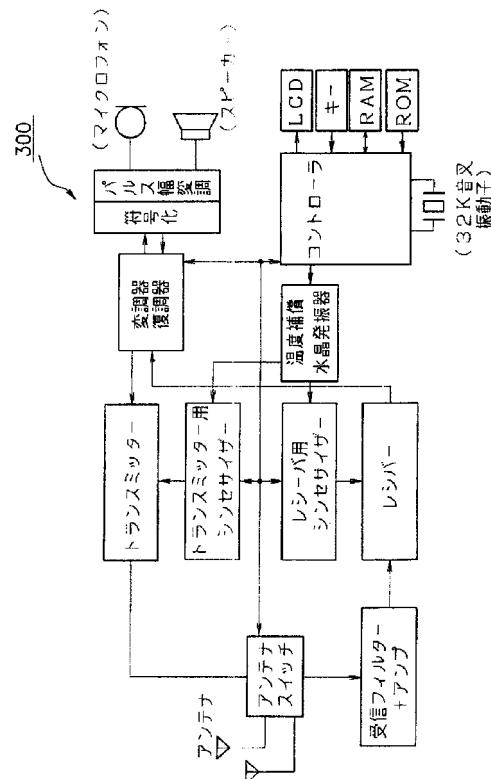
【図 7】



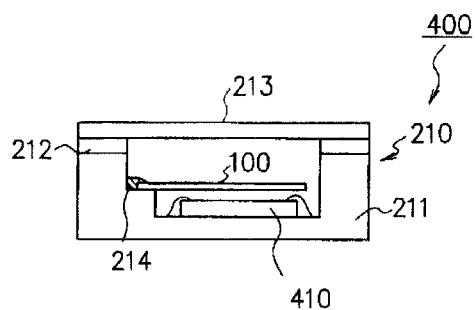
【図 8】



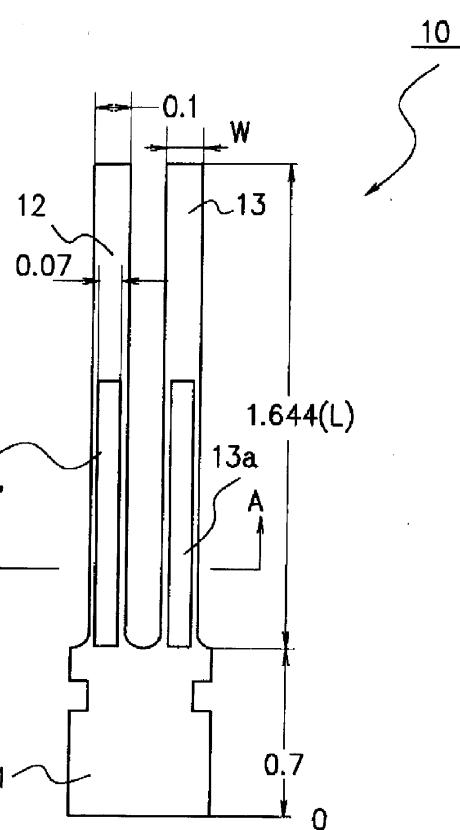
【図 9】



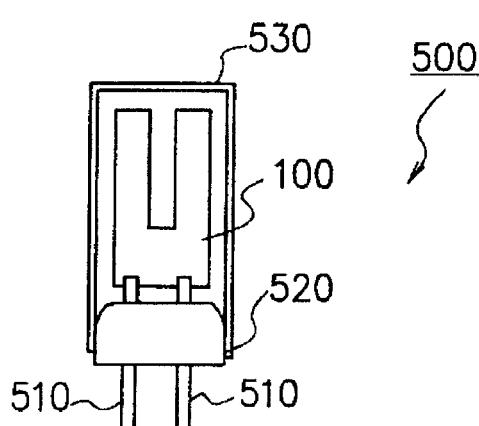
【図10】



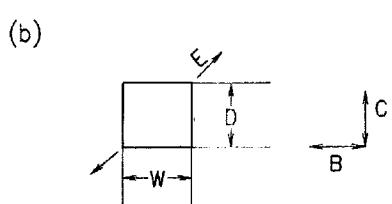
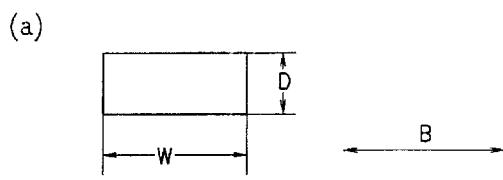
【図12】



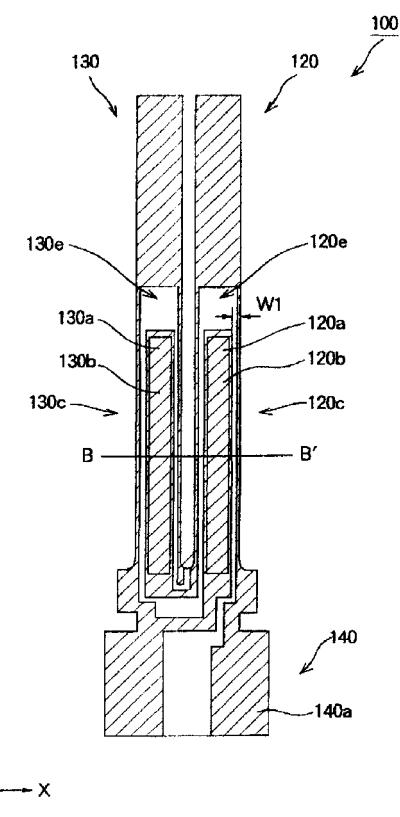
【図11】



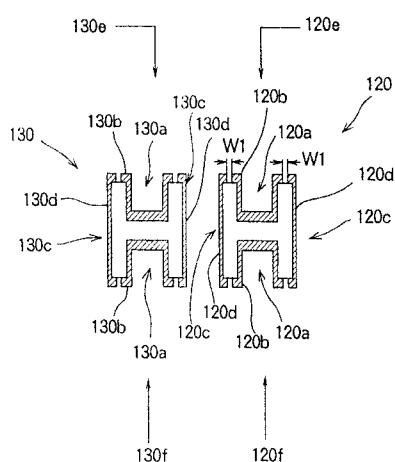
【図13】



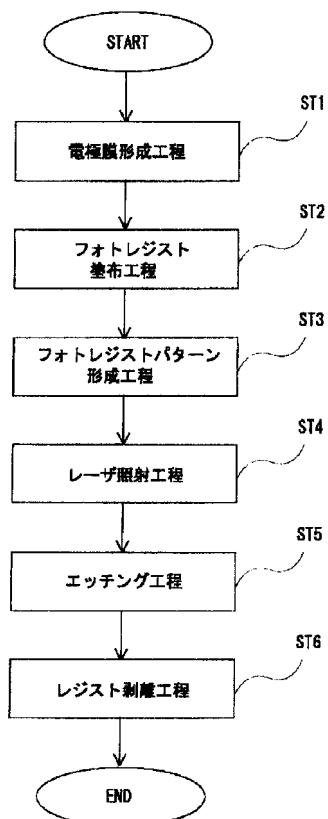
【図14】



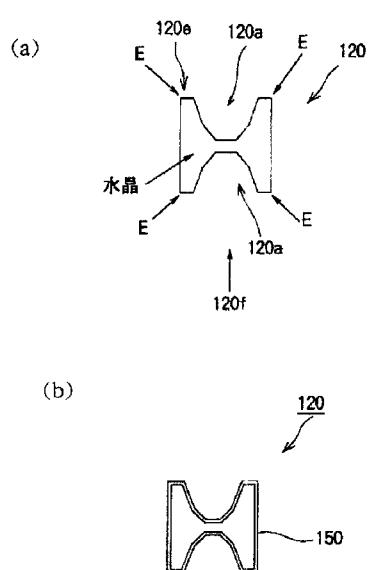
【図15】



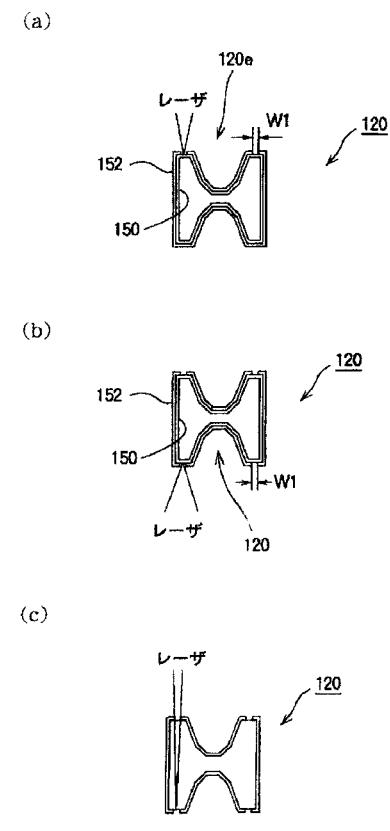
【図16】



【図17】

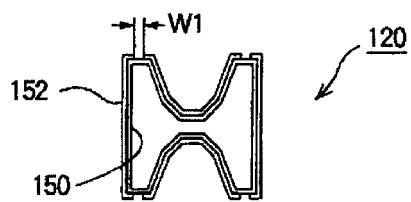


【図18】

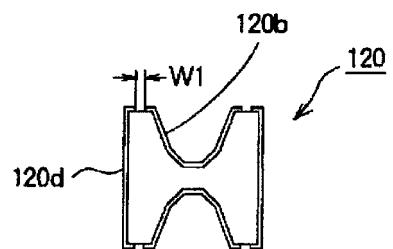


【図19】

(a)



(b)



フロントページの続き

審査官 井上 弘亘

(56)参考文献 特開2002-261575(JP,A)
国際公開第00/44092(WO,A1)
実開昭49-46668(JP,U)
特開昭59-183520(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H 03 H	9 / 19
H 03 B	5 / 32
H 03 H	9 / 02
H 03 H	9 / 215